

S. D. R. M.

ACTIVITÉ RADIO

DOCUMENTATION TECHNIQUE

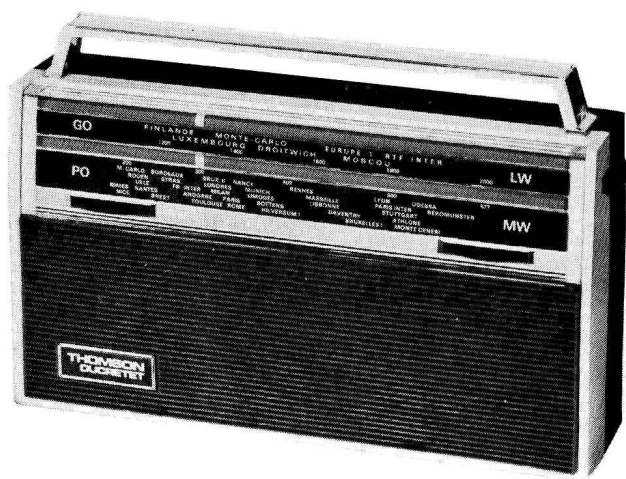
3^e Edition

RECEPTEURS RADIO

Version Silicium PNP



DT 180



DT 201

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

CHASSIS

NOMBRE DE TRANSISTORS

NOMBRE DE DIODE

GAMMES D'ONDES

SELECTION

COLLECTEUR D'ONDES

FREQUENCE FI

ETAGE DE PUISSANCE

HAUT - PARLEUR

PUISSANCE MODULEE

ALIMENTATION

PRESENTATION

DIMENSIONS

POIDS

Type 7 Z 7 - 7 Z 17

7.

1.

2 - PO 520 KHz à 1620 KHz.

GO 150 KHz à 270 KHz.

Par contacteur 2 touches.

Cadre ferrite 140 mm.

480 KHz.

Push-Pull sans transfo de sortie.

Circulaire \varnothing 92 mm - $Z = 15 \Omega$.

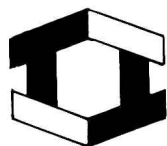
250 mW.

Par 2 piles plates standard de 4,5 V.

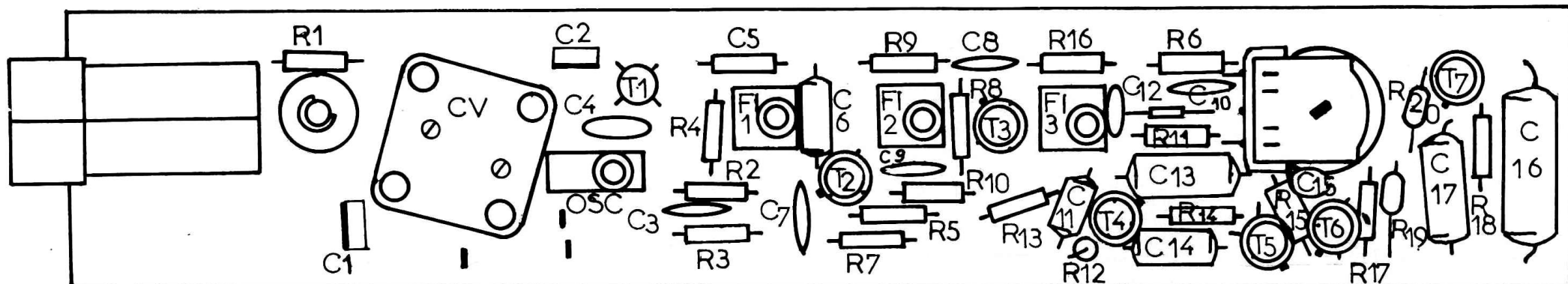
Coffret matière moulée.

Longueur 245 mm - Hauteur 170 mm - Profondeur 60 mm.

700 gr sans pile.



**THOMSON
DUCRETET**



Circuit Imprimé n° 9 036 009/2

RÉSISTANCES

Repère	Type	Valeur (en Ω)	Tolérance	Puissance	Référence
R. 1	RMI	180 K	$\pm 10 \%$	0,5 W	
R. 2	—	22 K	—	—	
R. 3	—	6,8 K	—	—	
R. 4	—	2,2 K	—	—	
R. 5	—	82 K	—	—	
R. 6	—	10 K	—	—	
R. 7	—	470	—	—	
R. 8	—	4,7 K	—	—	
R. 9	—	27 K	—	—	
R. 10	—	1 K	—	—	
R. 11	—	4,7 K	—	—	
R. 12	—	4,7 K	—	—	
R. 13	—	5,6 K	—	—	
R. 14	—	100 K	—	—	
R. 15	—	220 K	—	—	
R. 16	—	150	—	—	
R. 17	—	56	—	—	
R. 18	—	330	—	—	
R. 19	—	1	$\pm 5 \%$	—	
R. 20	—	1	—	—	
R. 21	—	470	$\pm 10 \%$	—	
R. 22	CTN	33	$\pm 20 \%$	—	1 552 504/2

CONDENSATEURS

Repère	Type	Valeur (en F)	Tolérance	TS - TE (en volts)	Référence
C. 1	Mica	45 p	$\pm 2,5 \%$		
C. 2	—	163 p	—		
C. 3	Céram.	47 n	$-20+80 \%$	30	
ou	Polyest.	47 n	$\pm 20 \%$	30	
C. 4	—	22 n	—	250	
C. 5	Styro.	900 p	$\pm 2,5 \%$	160	
C. 6	Chim.	2 μ	$-10+150 \%$	12/15	1 369 022/2
C. 7	Céram.	47 n	$-20+80 \%$	30	
ou	Polyest.	47 n	$\pm 20 \%$	30	
C. 8	Céram.	22 n	$-20+80 \%$	30	
C. 9	—	47 n	—	30	
ou	Polyest.	47 n	$\pm 20 \%$	30	
C. 10	Céram.	22 n	$-20+80 \%$	30	
C. 11	Chim.	2 μ	$-10+150 \%$	12/15	1 369 022/2
ou	—	2 μ	—	6/8	1 369 539/2
C. 12	Céram.	10 n	$-20+50 \%$	250	
C. 13	Chim.	100 μ	$-10+50 \%$	10/12	1 369 007/2
C. 14	—	22 μ	$-10+150 \%$	12/15	1 369 002/2
C. 15	Céram.	220 p	$\pm 20 \%$	500	
C. 16	Chim.	250 μ	$-10+50 \%$	10/12	1 369 023/2
ou	—	220 μ	—	10/12	1 369 023/2
ou	—	200 μ	—	10	1 369 540/2
C. 17	—	100 μ	—	10/12	1 369 007/2

ALIGNEMENTS — RÉGLAGES DES CIRCUITS

* APPAREILS A UTILISER :

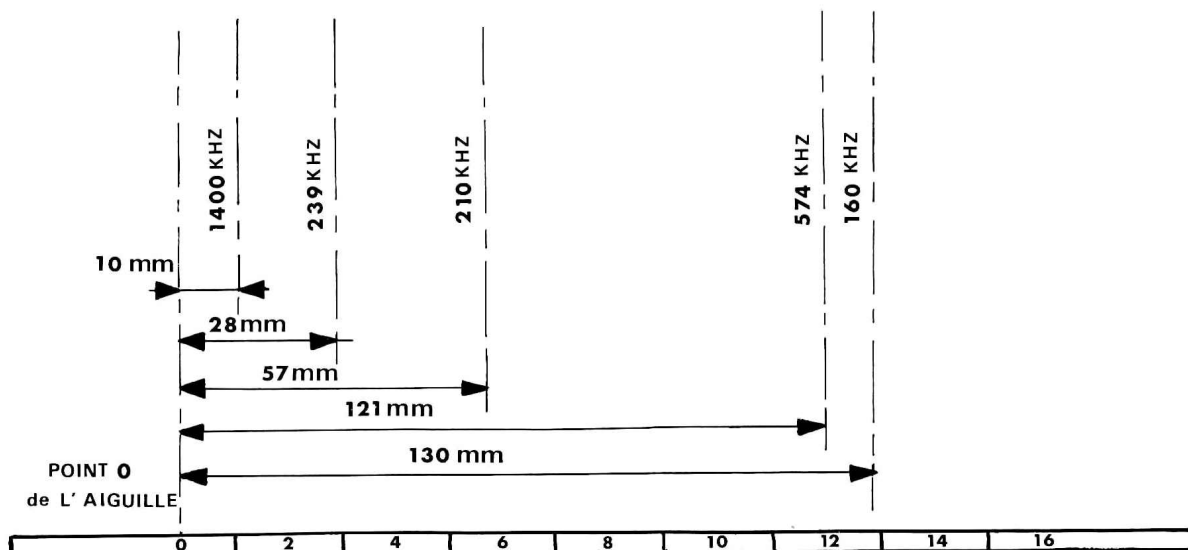
— Générateur HF
— Voltmètre alternatif

— Résistance de $15\ \Omega$ - 0,5 W remplaçant le HP.

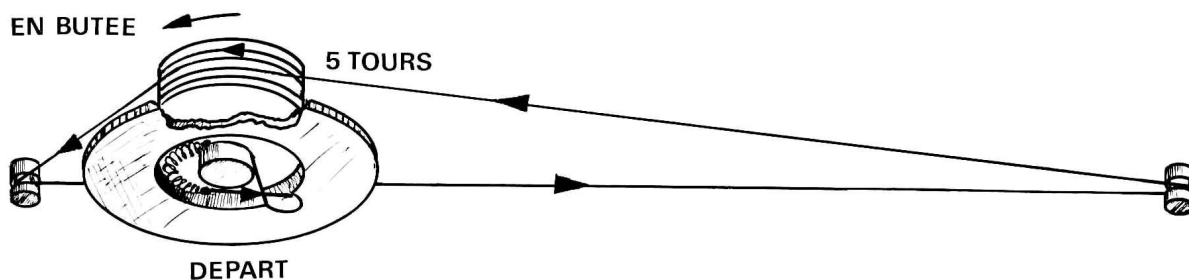
— Contrôleur universel
— Boucle rayonnante

ORDRE DES OPERATIONS		RECEPTEUR	GENERATEUR (à travers boucle rayonn.)	CIRCUIT A REGLER	SORTIE
REGLAGE F I		CV Ouvert touche PO enfoncée	480 KHZ	FI 3 - FI 2 - FI 1 reprendre ces réglages	VL en parallèle sur HP Sortie maxi
PO	OSCILLATEUR	CV Fermé en butée CV Ouvert en butée	520 KHZ 1620 KHZ	Bobine oscillatrice PO Trimmer oscillateur PO (CV)	Sortie maxi
	ACCORD	Avec CV, chercher signal à 574 KHZ 1400 KHZ	574 KHZ 1400 KHZ	Bobine PO du cadre Trimmer accord PO (CV)	Maxi
GO	ACCORD	Avec CV, chercher signal à 210 KHZ	210 KHZ	Bobine GO du cadre	Maxi

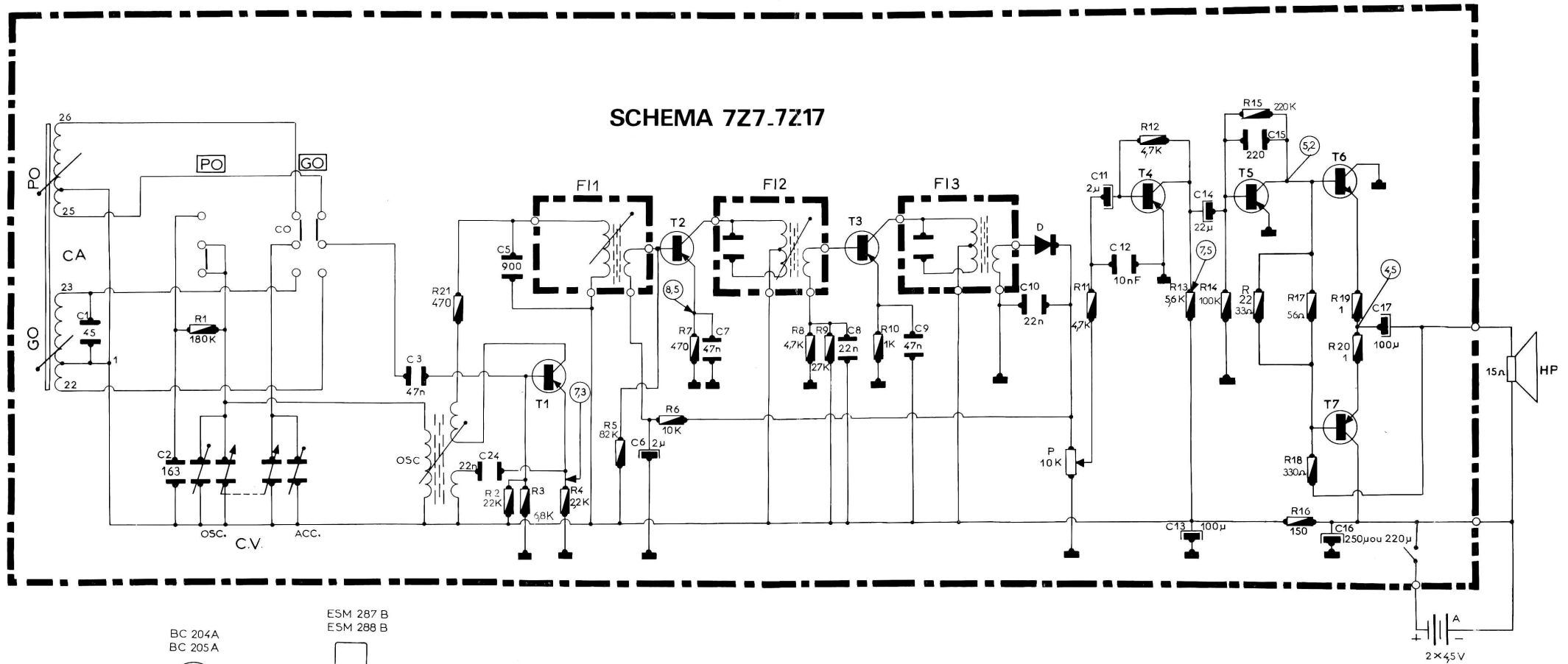
POINTS DE REGLAGES DU CADRAN



ENTRAINEMENT DE L' AIGUILLE

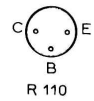


SCHEMA 7Z7.7Z17

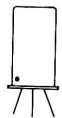


3^e édition - version silicium

BC 204A
BC 205A



ESM 287 B
ESM 288 B



○ Tensions en volts continues
PO - CV ouvert sans signal

T. 1	Transistor	
T. 2	—	<div> <div>BC 204 A</div> <div>ou</div> <div>BC 205 A</div> </div>
T. 3	—	
T. 4	—	
T. 5	—	
T. 6	—	ESM 287 B
T. 7	—	ESM 288 B

Diode A.D.

Gammes Couvertes

PO 520 à 1.620 KHz

GO 150 à 270 KHz

FI 480 KHz.